BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11264981 A

(43) Date of publication of application: 28 . 09 . 99

(51) Int. CI

G02F 1/1337 C08G 73/10

(21) Application number: 10088149

(22) Date of filing: 17 . 03 . 98

(71) Applicant:

CHISSO CORP

(72) Inventor:

SHIMIZU IOKATSU KATO HARUO **MURATA SHIZUO**

performance to the antiferroelectric liquid crystals as well is not known.

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

(54) ALIGNING AGENT FOR ANTIFERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT. ALIGNMENT LAYER USING THE ALIGNING AGENT AND ANTIFERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT HAVING THE **ALIGNMENT LAYER**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the alignment characteristic of antiferroelectric liquid crystals by using an aligning agent contg. specific polyamide acid.

SOLUTION: The alignment layer is formed by applying the aligning agent prepd. by dissolving polyimide precursor (hereafter described as 'varnish') having the repeating unit expressed by formula I or a polymer obtd. by partial imidization of the precursor into a solvent on a substrate with electrodes, removing the solvent by heating, imidizing the soln, by dehydration and ring closure and then subjecting the coating to a rubbing treatment. In the formula I, X denotes an arom. tetracarboxylic acid residue; Y denotes the diamine residue expressed by formula II. In the formula II, R denotes hydrogen or methyl group. The polyamide acid expressed by the formula I is known as a raw material of the polyimide for the alignment layers of nematic liquid crystal display elements but the fact that the alignment layer formed by imidzation of the polyamide acid or its partially imidized polymer has excellent alignment

(11)特許出願公開番号

特開平11-264981

(43)公開日 平成11年(1999) 9月28日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

G02F 1/1337 C 0 8 G 73/10

510

FΙ

G02F 1/1337 510

C 0 8 G 73/10

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平10-88149

(22)出願日

平成10年(1998) 3月17日

(71)出願人 000002071

チッソ株式会社

大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号

(72)発明者 清水 五男雄

千葉県市原市辰巳台東3丁目27番地の2

(72)発明者 加藤 春雄

千葉県市原市山田橋628番地1

(72)発明者 村田 鎮男

千葉県市原市椎津545番地9

(74)代理人 弁理士 野中 克彦

(54) 【発明の名称】 反強誘電性液晶表示素子用配向剤、該配向剤を用いた配向膜、及び該配向膜を有する反強誘電性 液晶表示素子

(57)【要約】

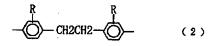
【課題】 ネマチック液晶や強誘電性液晶と比較して配 向性の悪い、反強誘電性液晶材料の配向性を改良する事 を課題としたものである。

【解決手段】 式(1)で示す繰り返し単位を有する、 ポリアミド酸あるいは、該ポリアミド酸の部分イミド化 したポリマーを溶剤に溶解したワニスを電極付き基板に 塗布し、加熱により溶剤を除去し、脱水・閉環してイミ ド化した後、ラビング処理して配向膜とする事により、 配向性に優れた反強誘電性液晶素子を提供する。

【化1】

(式中、Xは芳香族テトラカルボン酸残基、Yは式 (2) で示される基である。)

【化2】



(式中、Rは水素、又はメチル基である。)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記式(1)の繰り返し単位を有するポ リアミド酸を0.1~40重量%含有する配向剤。

【化1】

(式中、Xは芳香族テトラカルボン酸を示し、Yは下記 10 式(2)で表されるジアミン残基を示す。) 【化2】

(式中、Rは水素、又はメチル基を示す。)

【請求項2】 式(1)及び式(2)において、Xがフ エニル基またはビフェニル基であり、Rが水素である請 求項1に記載の反強誘電性液晶表示素子用配向剤。

【請求項3】 式(1)及び式(2)においてXがフェ ニル基またはビフェニル基であり、Rがメチル基である 請求項1に記載の反強誘電性液晶表示素子用配向剤。

【請求項4】 請求項1~3の何れか1項に記載の反強 誘電性液晶表示素子用配向剤を塗布し、焼成して得られ る反強誘電性液晶表示素子用配向膜。

【請求項5】 請求項4に記載の配向膜を有する反強誘 電性液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、反強誘電性液晶分 子の配向性に優れた、液晶表示素子に関するものであ る。特に、反強誘電性液晶表示素子用の配向膜、及びこ の配向膜用の配向剤を提供するものである。

[0002]

【背景技術】従来の液晶表示素子はネマチック液晶を用 いた表示素子が殆どである。ネマチック液晶表示素子と 比較して反強誘電性液晶表示素子の大きく異なる特徴 は、極めて早い応答速度と広い視野角特性を有する点に ある。従って、反強誘電性液晶表示素子は、ネマチック 液晶表示素子では達成出来ない新たな表示素子としての 40 期待が持たれている。ネマチック液晶表示素子と比較し て強誘電性液晶表示素子の大きく異なる特徴は、極めて 早い応答速度とメモリー性を有する点にある。しかし、 現時点においては、強誘電性液晶及び反強誘電性液晶表 示素子とも、殆ど実用化されていない。強誘電性液晶及 び反強誘電性液晶は層構造を有しているので、通常のネ マティック液晶と比較して、均一な配向を得ることが難 しく、また液晶表示素子の厚み (セルの厚み) がネマチ ック液晶表示素子に比べて薄い事によりセル厚の不均一 性が表示斑に大きく影響する等の問題がある。配向性が 50

悪い事の弊害として、表示画面に配向状態の異なるドメ インが現れ、画面が見づらくなる。あるいは、電界の印 加に対して、コントラストが小さくなる等の問題が発生 する。強誘電性液晶の場合は、カイラルスメクチックC 相よりも高温側にスメクチックA相及びネマチック相を 有する液晶材料を用い、ネマチック相の状態まで昇温し て液晶分子を配向させ、その状態から徐々に温度を下げ て、スメクチック A相を経てカイラルスメクチック C相 にすることで好ましい配向状態とする方法が行われてい る。一方、反強誘電液晶材料においては、今のところカ イラルスメクチックCA相(反強誘電性液晶相)より高 温側にネマチック相を有する液晶性化合物が見いだされ ていないので、液晶分子の配向が一層困難である。強誘 電性液晶用の配向膜の形成には、種々の方法が試みられ ている。例えば、真空蒸着法による無機化合物薄膜ある いは有機化合物薄膜の形成方法、ラングミュアプロジェ ット法(LB膜形成法)による薄膜の形成方法、あるい は、ポリイミド薄膜をラビング処理や光照射処理する方 法等である。これらの中で、真空蒸着法やLB膜形成法

2

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 状況にある反強誘電性液晶の配向性を向上させる事を目 的とするものであり、ひいては、モノドメインを有する 優れた反強誘電性液晶表示素子を提供しようとするもの である。

は作業性に難点があり、せん断力による方法や温度勾配

法は、配向性の持続性に難点がある。、ポリイミド膜を

ラビング処理して配向膜とする方法は、ネマチック液晶

表示素子の作成方法として工業的に実施されている方法

であり、作業性も良く、反強誘電性液晶表示素子におい

ても最も現実的な方法であると考えられる。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、このよう な点に鑑み、ラビング処理によるポリイミド配向膜用の ポリイミドの分子構造に注目して鋭意検討した結果、本 発明を完成するに至った。即ち、本発明は、式(1)で 表される繰り返し単位を有する、ポリイミド前駆体ある いは該前駆体を部分イミド化したポリマーを溶剤に溶解 した配向剤(以下単にワニスということがある)を電極 付き基板に塗布し、加熱により溶剤除去、脱水・閉環し てイミド化した後、ラビング処理を施して配向膜とする 事により、配向性に優れた反強誘電性液晶素子を提供す るものである。

[0005]

【化3】

30

【0006】(式中、Xは芳香族テトラカルボン酸残基 を示し、Yは下記式 (2) で表されるジアミン残基を示 す。)

【化4】

(式中、Rは水素、又はメチル基を示す。)

上記式(1)で表されるポリアミド酸はネマチック液晶 表示素子の配向膜用ポリイミドの原料として知られてい るが、このポリアミド酸又はその部分イミド化ポリマー をイミド化した配向膜が反強誘電性液晶に対しても優れ た配向性能を有することは知られていない。

【0007】Xで表される芳香族テトラカルボン酸残基 を与える好ましい化合物として、ピロメリット酸二無水 物、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、及びナフタ レンテトラカルボン酸二無水物を例示できる。又、本発 明の効果を損なわない限りにおいて、これらの芳香族テ トラカルボン酸二無水物の一部を他の芳香族テトラカル ボン酸、脂環式テトラカルボン酸、脂肪族テトラカルボ ン酸あるいは、シロキサン系テトラカルボン酸等で置換 する事も可能である。

【0008】そのような他のテトラカルボン酸として、 下記の化合物が例示できる。3、3'、4、4'ージフ ェニルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4' ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2、3、 6、7ーナフタレン酸無水物等のナフタレン酸二無水 物、3、3'ー4、4'ービフェニルスルホンテトラカ ルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルエ ーテルテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4' -ジメチルジフェニルシランテトラカルボン酸二無水 物、3,3',4,4'-テトラフェニルシランテトラ カルボン酸二無水物、1,2,3,4-フランテトラカ ルボン酸二無水物、4,4'ービス(3,4ージカルボ キシフェノキシ) ジフェニルスルフィド二無水物、4, 4'-ビス(3, 4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェ ニルスルホン二無水物、4,4'ービス(3,4ージカ ルボキシフェノキシ) ジフェニルプロパン二無水物、 3,3',4,4'ーパーフルオロピリデンジフタル酸 二無水物、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカル 40 ボン酸二無水物、ビス (フタル酸) フェニルスルフィン オキサイド二無水物、p-フェニレンービス(トリフェ ニルフタル酸) 二無水物、m-フェニレン-ビス (トリ フェニルフタル酸) 二無水物、ビス (トリフェニルフタ ル酸) - 4, 4' - ジフェニルエーテル二無水物、ビス (トリフェニルフタル酸) -4,4'-ジフェニルメタ ン二無水物、等の芳香族テトラカルボン酸二無水物;エ チレンテトラカルボン酸二無水物、デカヒドロナフタレ ンー1,4,5,8-テトラカルボン酸二無水物、4,

ナフタレンー1,2,5,6-テトラカルボン酸二無水 物、シクロペンタンー1,2,3,4-テトラカルボン 酸二無水物、プタン-1,2,3,4-テトラカルボン 酸二無水物、ビシクロ(2, 2, 2) -オクト(7) -エンー2, 3, 5, 6ーテトラカルボン酸二無水物、シ クロヘキサン-1,2,5,6-テトラカルボン酸二無 水物、ブタンテトラカルボン酸二無水物、 3, 3'ービ シクロヘキシルー1, 1', 2, 2'ーテトラカルボン 酸二無水物、2,3,5-トリカルボキシシクロペンチ ル酢酸二無水物、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロ フラル)-3-メチル-3-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸二無水物、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b -ヘキサヒドロー5ーテトラヒドロー2, 5ージオキソー 3-フラニル) -ナフト [1, 2, -c] -フラン-1, 3-ジオン、3, 5, 6-トリカルボキシノルボル ナンー2-酢酸二無水物、2,3,4,5-テトラヒド ロフランテトラカルボン酸二無水物、等の脂肪族及び脂 環族テトラカルボン酸二無水物。これらの酸二無水物に よる置換量は、好ましくは50モル%以下である。これ らのテトラカルボン酸が50モル%を越えると反強誘電 性液晶分子の配向が阻害されやすくなる。

【0009】式(2)で示されるジアミン残基を与える 化合物として下記の化合物が例示できる。4、4'ージ アミノージメチルジフェニルエタン、4、4'ージアミ ノ2、2'ージメチルジフェニルエタン4、4'ージア ミノ3、3'ージメチルジフェニルエタン、4、4'ー ジアミノ2、3'ージメチルジフェニルエタン。これら のジアミンはそれぞれ単独で使用することもできるが、 2種類以上を混合して使用することもできる。又、本発 明の効果を阻害しない範囲内において、上記のジアミン の一部を他の芳香族ジアミン、脂肪族ジアミン、脂環式 ジアミン、シロキサン系ジアミン等のジアミンに置換す ることができる。その置換量は好ましくは、50モル% 以下に抑えるべきである。50モル%を越えると反強誘 電性液晶分子の配向性が阻害されやすくなる。更に好ま しくは、30モル%以下である。

【0010】上記のジアミンと置換することのできる他 のジアミンとして、下記の化合物が例示できる。2,2 ービス [4ー (4ーアミノフェノキシ) フェニル] プロ パン、2, 2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フ エニル] ヘキサフルオロプロパン、m-フェニレンジア ミン、pーフェニレンジアミン、mーキシリレンジアミ ン、p-キシリレンジアミン、2,2'-ジアミノジフ エニルプロパン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテ ル、ベンジジン、1、1-ピス[4-(4-アミノフェ ノキシ) フェニル] シクロヘキサン、1, 1ービス [4 - (4-アミノフェノキシ) フェニル] -4-メチルシ クロヘキサン、1、1-ビス[4-(4-アミノフェノ キシ) フェニル] -4-エチルシクロヘキサン、1,1 8-ジメチル-1, 2, 3, 5, 6, 7-ヘキサヒドロ 50 -ビス [4- (4-アミノフェノキシ) フェニル]-4

10

ープロピルシクロヘキサン、1,1ービス[4ー(4ー アミノフェノキシ) フェニル] -4-ブチルシクロヘキ サン、1、1ービス [4-(4-アミノフェノキシ) フ ェニル] - 4 - ペンチルシクロヘキサン、ビス [4-(4-アミノベンジル) フェニル] メタン、1, 1-ビ ス[4-(4-アミノベンジル)フェニル]シクロヘキ サン、1, 1-ビス [4-(4-アミノベンジル) フェ ニル] 4-メチルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4-(4-アミノベンジル) フェニル] 4-エチルシクロへ キサン、1, 1ービス [4-(4-アミノベンジル) フ エニル] 4-nプロピルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4-(4-アミノベンジル) フェニル] 4-nブチル シクロヘキサン、1、1-ビス[4-(4-アミノベン ジル)フェニル] 4-nペンチルシクロヘキサン、4、 4'-パラアミノフェノキシービフェニル1,1-ビス [4-(4-アミノベンジル) フェニル] シクロヘキサ ン、1, 1ービス [4-(4-アミノベンジル) フェニ ル] - 4 - メチルシクロヘキサン、1, 1 - ビス [4 -(4-アミノベンジル) フェニル] -4-エチルシクロ ヘキサン、1、1ービス [4-(4-アミノベンジル) フェニル] -4-プロピルシクロヘキサン、1,1-ビ ス [4-(4-アミノベンジル) フェニル] -4-ブチ ルシクロヘキサン、1、1-ビス[4-(4-アミノベ ンジル)フェニル]-4-ペンチルシクロヘキサン、 1, 1-ビス [4-(4-アミノベンジル) フェニル] -4-ヘキシルシクロヘキサン、1, 1-ビス [4-(4-アミノベンジル) フェニル] -4-ヘプチルシク ロヘキサン、1, 1-ビス [4-(4-アミノベンジ ル)フェニル] -4-オクチルシクロヘキサン、1,1

【0011】更に、これらのテトラカルボン酸二無水物 及びジアミン以外にポリアミド酸の反応末端を形成す る、モノアミン化合物、又は、/及び、モノカルボン酸 無水物を併用する事も可能である。基板への密着性を良 くするために、アミノシリコン化合物またはジアミノシ リコン化合物を導入することも出来る。アミノシリコン 化合物としては、パラアミノフェニルトリメトキシシラ ン、パラアミノフェニルトリエトキシシラン、メタアミ ノフェニルトリメトキシシラン、メタアミノフェニルト リエトキシシラン、アミノプロピルトリメトキシシラ ン、アミノプロピルトリエトキシシラン等が挙げられ る。ジアミノシリコン化合物としては、1、3-ビス (3-アミノプロピル) -1, 1, 1-テトラフェニル シロキサン、1、3ービス (3ーアミノプロピル) -1, 1, 1-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ビス (4-アミノプチル) -1, 1, 1-テトラメチルジシ ロキサン等が挙げられる。

ービス[4-(4-アミノベンジル)フェニル]メタ

[0012]

【発明の実施の形態】以下に、より具体的に本発明の実 50

施の形態を述べる。式(1)の繰り返し単位は、芳香族 テトラカルボン酸二無水物及び4、4'ージアミノジフ エニルエタン、4、4'ージアミノ3、3'ージメチル ジフェニルエタン、あるいは、4、4'ージアミノ2、 2'ージメチルジフェニルエタンを反応させる事により 得る事が出来る。又、本発明のポリマーに他の構造のポ リマーを混合して用いる事も出来るが、この場合でも、 本発明のポリマーが主成分になる事が必要である。好ま しくは、60%以上、更に好ましくは、80%以上本発 明のポリマーを含有する事が好ましい。ここに他の構造 のポリマーとは、他のポリアミド酸、ポリイミド、ポリ アミドイミド、ポリエーテルアミド、ポリエーテルイミ ド、ポリエステルアミド、ポリエステルイミド、ポリア ミド等を挙げる事が出来る。

6

【0013】本発明で用いられる配向剤は、式(1)で 示されるポリアミド酸またはその部分イミド化物を溶剤 に溶解したワニスであり、その濃度が0.1-40重量 %の範囲のモノが好ましく、さらに好ましくは、0.5 ー20重量%である。ポリマー濃度が、0.1%以下で は、配向膜としての膜厚が薄くなりすぎて好ましくな い。濃度が10%以上のワニスでは、これを直接塗布す ると膜厚が厚くなりすぎるきらいがあるので、使用時に 適宜希釈する。更に、40%以上では、粘度が高すぎ て、希釈に用いる溶剤とうまく混合出来ない等の弊害が 出てきて好ましくない。ワニスに使用される溶剤は、ポ リアミド酸あるいは可溶性ポリイミドの溶剤として通常 使用されている下記の溶剤を使用する事が出来る。ポリ アミド酸に対して親溶剤である、Nーメチルー2ーピロ リドン (NMP) 、ジメチルイミドゾリジノン、N-メ 30 チルカプロラクタム、N-メチルプロピオンアミド、 N, N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホオキシ ド、N, Nジメチルホルムアミド、N, N-ジエチルホ ルムアミド、ジエチルアセトアミド、及びァーブチルラ クトン等の非プロトン性極性有機溶剤;塗布性改善など の目的で、乳酸アルキル、3-メチル、3-メトキシブ タノール、テトラリン、イソホロン、エチレングリコー ルモノアルキルエーテル (エチレングリコールモノブチ ルエーテル等)、ジエチレングリコールモノアルキルエ ーテル(ジエチレングリコールモノエチルエーテル 40 等)、エチレングリコールモノアルキル又はフェニルア セテート、トリエチレングリコールモノアルキルエーテ ル、プロピレングリコールモノアルキルエーテル (プロ ピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリ コールモノアルキルエステル等)、マロン酸ジアルキル (マロン酸ジエチル等) 等の表面張力の低い溶剤。本発 明のワニスには、イミド化を促進する等の目的で触媒を 添加する事も可能であり、更に、塗布性を改良する等の 目的で界面活性剤を配合すること、帯電防止の目的等で

帯電防止剤を配合すること、更に、基板との密着性を向

上させる為にシランカップリング剤あるいはチタン系の

カップリング剤を配合することも出来る。

【0014】これらの溶剤で溶解されたワニスを液晶配向素子を形成する基板へ塗布する方法として、スピンナー法、印刷法、ディッピング法、滴下法等の通常使用されている方法が使用可能である。ワニスを塗布した後は、比較的低温で溶剤を蒸発させた後、150-300° C程度の温度で加熱処理する事が好ましい。これら溶剤の乾燥や脱水・閉環反応に要する加熱処理には、オーブン、ホットプレート、赤外線炉等の、通常ポリアミド酸のイミド化に使用している方法で実施する事が可能で10ある。本発明は、反強誘電性液晶表示素子用配向膜として好ましく用いられるが、ブックシェルフ型配列を有する強誘電性液晶表示素子用配向膜としても使用する事が出来る。

[0015]

【実施例】以下に、ポリアミド酸の合成に用いたテトラカルボン酸二無水物及びジアミンとその略号を記載する。

[酸二無水物]

ピロメリット酸 : PMDA シクロブタンテトラカルボン酸二無水物 : CBDA ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 : BPDA 「ジアミン」

4, 4'ージアミノジフェニルエタン : DPE 4, 4'ージアミノー3、3'ージメチルージフェニル エタン: DMDPE

4, 4'ージアミノジフェニルメタン : DPM 2, 2'ービス ((4-アミノフェノキシ) フェニル) プロパン: DPOP

【0016】実施例1

(ポリアミド酸の合成) 温度計、攪拌機、及び窒素ガス 導入口を備えた200ml三つ口フラスコにDPEを 1.4797g(6.970mmol)、脱水NMP9 4.17gを入れ、乾燥窒素気流下攪拌溶解した。反応 系の温度を10℃に保ちながらPMDAを1.5203 g(6.970mmol)を添加し、反応温度を約60 。 C以下に抑えて30時間反応させて、ポリマー濃度3 %のポリアミド酸母液1を合成した。母液11の粘度は 345mPa・s(E型粘度計を使用、25℃)であった。また、ゲルパーミエションクロマトグラフィ法により測定した結果、ポリアミド酸の重量平均分子量は3 2.7万であった。

(ワニスの調製) 上記の母液 1に γ ープチロラクトン及びプチルセロソルブを添加して、ポリアミド酸 1.5%、NMP 48.5%、 γ ープチロラクトン 16.7%、ブチルセロソルブ 33.3%のワニス 1 を調合した

【0017】 (セルの作成) ITO (Indium Tin Oxid e) 電極付き基板 2枚 (30×40mm、30×30m m各一枚) のITO電極側にワニスをスピンナーで塗布 50

し、 80° Cのホットプレート上で溶剤を乾燥し、更に、 200° Cにセットされたオープン中で90分加熱処理した。 30×30 mmの基板のポリイミド膜の表面をレーヨン系の布でラビングして一軸配向処理を行った。 2μ のシリカスペーサーをラビング処理した基板側のポリイミド膜側に散布し、ラビング処理していない基板(30×40 mm)のポリイミド膜側を内側にして組

み合わせ、エポキシシール剤で周辺を部分的にシールして配向性評価用開放セルを作成した (ラビング処理していない基板のポリイミド膜面 (10×30mm) が現れている)。

(配向性評価) 前記の開放セルのラビング処理していない基板のポリイミド膜上に反強誘電性液晶(CS-4001:チッソ(株)製)を滴下し、毛管現象でセル内へ浸透させた後、 100° Cにセットしたホットプレート上で加熱して、反強誘電性液晶をアイソトロピック相に転移させ、次いでセルを室温まで放冷した。無電界時に直交ニュル下で暗黒状態になる位置にセルを設定し、 $+10V/\mu$ m又は $-10V/\mu$ mの電界を印加した時の配向性を偏光顕微鏡下で観察した。その結果、無電界時では、全面的に暗視野状態であり、電界印加時においては全面的に明視野となる状態が観察された。又、液晶の配向方向の異なる領域を示すドメインは観察されなかった。

【0018】実施例2

30

DMDPE3. 1455g(13.087mmo1)、脱水NMP91.25g、PMDA2.8545g(13.087mmo1)を用いた以外は実施例1と同様にして、ポリマー濃度6%のポリアミド酸母液2を合成した。母液2の粘度は980mPa・sであり、ポリアミド酸の重量平均分子量は18.4万であった。得られた母液2に更に、NMP、γーブチロラクトン、ブチルセロソルブを添加して、ポリアミド酸1.5%、NMP48.5%、γーブチロラクトン 16.7%、ブチルセロソルブ 33.3%のワニス2を調合した。以下、実施例1と同様にして、解放セルを作製し、配向性の評価を行った。その結果を表1に示した。

【0019】実施例3

DPM0.9335g(4.708mmol)、DPE
1.4992g(7.062mmol)、脱水NMP9
2.22g、PMDAを2.5673g(11.770mmol)を用いた以外は実施例1と同様にして、ポリマー濃度5%のポリアミド酸母液3を合成した。母液3の粘度は285mPa・sであり、ポリアミド酸の重量平均分子量は30.1万であった。得られ母液3に更に、NMP、γープチロラクトン、プチルセロソルブを添加して、ポリアミド酸1.5%、NMP 48.5%、γープチロラクトン 16.7%、ブチルセロソルブ 33.3%のワニス3を調合した。以下、実施例1と同様にして、解放セルを作製し、配向性の評価を行っ

た。その結果を表1に示した。

【0020】実施例4

DPE2. 5308g (11.92mmol)、脱水N MP92. 22g、PMDA1. 3002g (5.96 1mmol)、及びCBDA1. 1690g (5.96 1mmol)を用いた以外は実施例1と同様にして、ポリマー濃度5%のポリアミド酸母液4を合成した。母液4の粘度は450mPa・sであり、ポリアミド酸の重量平均分子量は38.8万であった。得られ母液4に更に、NMP、γープチロラクトン、プチルセロソルブを添加して、ポリアミド酸1.5%、NMP 48.5%、γープチロラクトン 16.7%、プチルセロソルブ 33.3%のワニス4を調合した。以下、実施例1と同様にして、解放セルを作製し、配向性の評価を行った。その結果を表1に示した。

【0021】実施例5

DPE: 2. 0956g (9.871mmol)、脱水 NMP: 92.22g、BPDA: 2.9044g (9.872mmol)を用いた以外は実施例1と同様にして、ポリマー濃度5%のポリアミド酸母液5を合成した。母液5の粘度は980mPa・sであり、ポリアミド酸の重量平均分子量は29.5万であった。得られ母液5に更に、NMP、γーブチロラクトン、ブチルセロソルブを添加して、ポリアミド酸1.5%、NMP48.5%、γーブチロラクトン 16.7%、ブチルセロソルブ 33.3%のワニス5を調合した。以下、実施例1と同様にして、解放セルを作製し、配向性の評価を行った。このセルは、実施例1と同様の性能を示した。その結果を表1に示した。

【0022】比較例1

DPE2.5990g(12.243mmol)、脱水 NMP92.22g、及びCBDA2.410g(12.243mmol)を用いた以外は実施例1と同様にして、ポリマー濃度5%のポリアミド酸母液6を合成した。母液6の粘度は220mPa・sであり、ポリアミド酸の重量平均分子量は25.0万であった。得られ母液6に更に、NMP、γーブチロラクトン、ブチルセロソルブを添加して、ポリアミド酸1.5%、NMP 48.5%、γーブチロラクトン 16.7%、ブチルセロソルブ 33.3%のワニス6を調合した。以下、実 40 施例1と同様にして、解放セルを作製し、配向性の評価*

*を行った。このセルでは、電圧無印加状態において、液 晶配向の異なるドメインが多く、全面が均一に暗視野に ならなかった。その結果を表1に示した。

10

【0023】比較例2

DPM: 2.3808g(12.008mmol)、脱水NMP: 92.22g、PMDA: 2.6192g(12.008mmol)を用いた以外は実施例1と同様にして、ポリマー濃度5%のポリアミド酸母液7を合成した。母液7の粘度は190mPa・sであり、ポリアミド酸の重量平均分子量は18.2万であった。得られ母液7に更に、NMP、γーブチロラクトン、ブチルセロソルブを添加して、ポリアミド酸1.5%、NMP48.5%、γーブチロラクトン 16.7%、ブチルセロソルブ 33.3%のワニス8を調合した。以下、実施例1と同様にして、解放セルを作製し、配向性の評価を行った。DPEとDPMは構造的にかなり似ているが、意外にも配向性には効果がない事が判った。の結果を表1に示した。

【0024】比較例3

DPOP: 3. 2651g (7. 954mmol)、脱水NMP: 92. 22g、PMDA: 1. 7349g (7. 954mmol)を用いた以外は実施例1と同様にして、ポリマー濃度5%のポリアミド酸母液8を合成した。母液8の粘度は685mPa・sであり、ポリアミド酸の重量平均分子量は40.5万であった。得られ母液8に更に、NMP、γーブチロラクトン、ブチルセロソルブを添加して、ポリアミド酸1.5%、NMP48.5%、γーブチロラクトン 16.7%、ブチルセロソルブ 33.3%のワニス8を調合した。以下、実施例1と同様にして、解放セルを作製し、配向性の評価を行った。DPOPとDPMは比較的構造が似ているが、意外にも配向性には効果がない事が判った。その結果を表1に示した。

【0025】比較例4

ワニス1に代えて、PVAの1.5%水溶液を用い、焼成温度を150℃で60分行った以外は実施例1と同様の方法で解放セル25を作成し、以下実施例1と同様の方法で配向性を評価した。その結果は比較例1と同様であった。

[0026]

【表 1 】

実施例	ポリアミド酸組成 (モル比)							
及び	テトラカ	カルボン酸ニ	二無水物	ジアミン				配向性
比較例	PMDA	CBDA	BPDA	DPE	DPM	DMPE	DPOP	
実施例 1	1. 0			1. 0				モノドメイン
実施例 2	1. 0					1. 0		モノドメイン
実施例3	1. 0			0.6	0. 4			モノドメイン
実施例4	0. 5	0.5		1. 0				モノドメイン
実施例 5		~	1. 0	1. 0				モノドメイン
比较例 1		1. 0		1. 0				多数のドメイン
比較例2	1. 0				1. 0			多数のドメイン
比較例3	1. 0						1. 0	多数のドメイン
比较例4	ポリビニルアルコール							多数のドメイン

[0027]

【発明の効果】実施例及び比較例から判る様に、ジアミン化合物として、DPE、あるいはDMDPEを用い、テトラカルボン酸二無水物にPMDA、あるいはBPD*

* Aを用いると、反強誘電性液晶分子は配向性が向上する。一方、類似の構造を有する4、4'ージアミノジフェニルメタンあるいはプロパンにおいては、このような優れた配向性は見られなかった。